

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-330634
(P2006-330634A)

(43) 公開日 平成18年12月7日(2006.12.7)

(51) Int. Cl.

G02F 1/1368 (2006.01)

F I

G02F 1/1368

テーマコード(参考)

2H092

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号

特願2005-158069 (P2005-158069)

(22) 出願日

平成17年5月30日(2005.5.30)

(71) 出願人

000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(74) 代理人

100101214

弁理士 森岡 正樹

(72) 発明者

木原 正博

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通ディスプレイテクノロジーズ
株式会社内

(72) 発明者

田口 善久

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通ディスプレイテクノロジーズ
株式会社内

Fターム(参考) 2H092 GA11 JA24 JA37 JA41 JA46

JB22 JB31 NA01 PA01 PA02

PA06 PA08 PA11 PA13

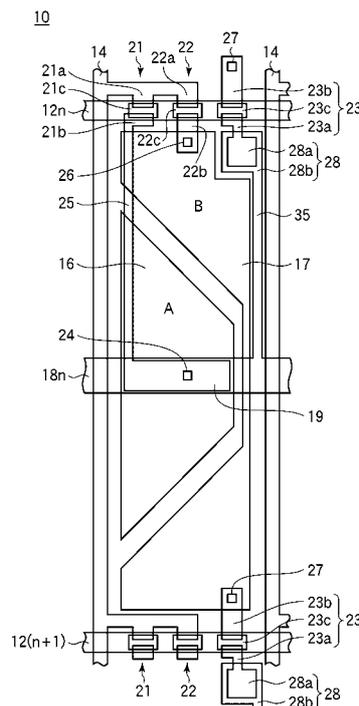
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】本発明は液晶表示装置に関し、良好な表示特性の得られる液晶表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 n 番目のゲートバスライン12 n とドレインバスライン14の交点近傍に設置された第1及び第2のTFT21, 22と、TFT21に電気的に接続された第1の画素電極16と、TFT22に電気的に接続された第1の画素電極16と分離された第2の画素電極17と、ソース電極が第2の画素電極17に電気的に接続された第3のTFT23と、第3のTFT23のドレイン電極23aに電気的に接続された、正方形形状の第1のバッファ容量電極28aと、絶縁膜を介して第1のバッファ容量電極28aに対向して配置され、蓄積容量バスライン18に電気的に接続された、正方形形状の第2のバッファ容量電極28bとを備えたバッファ容量部28とを有するように構成する。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に互いに並列して形成された複数のゲートバスラインと、
 前記複数のゲートバスラインに絶縁膜を介して交差して形成された複数のドレインバスラインと、
 前記ゲートバスラインに並列して形成された複数の蓄積容量バスラインと、
 n 番目の前記ゲートバスラインと前記ドレインバスラインの交点近傍に設置された第 1 及び第 2 の薄膜トランジスタと、
 前記第 1 の薄膜トランジスタに電氣的に接続された第 1 の画素電極と、
 前記第 2 の薄膜トランジスタに電氣的に接続され、前記第 1 の画素電極と分離された第 2 の画素電極と、
 (n + 1) 番目の前記ゲートバスラインと前記ドレインバスラインの交点近傍に設置され、ソース/ドレイン電極が前記第 2 の画素電極に電氣的に接続された第 3 の薄膜トランジスタと、
 前記第 3 の薄膜トランジスタのドレイン/ソース電極に電氣的に接続された、辺の数が 4 以上である正多角形状の第 1 のバッファ容量電極と、絶縁膜を介して前記第 1 のバッファ容量電極に対向して配置され、前記蓄積容量バスラインに電氣的に接続された、辺の数が 4 以上である正多角形状の第 2 のバッファ容量電極とを備えたバッファ容量部とを有することを特徴とする液晶表示装置。

10

【請求項 2】

20

請求項 1 記載の液晶表示装置において

前記辺の数が 4 以上である正多角形状の第 1 のバッファ容量電極に代えて円形状の第 1 のバッファ容量電極を有し、

前記辺の数が 4 以上である正多角形状の第 2 のバッファ容量電極に代えて円形状の第 2 のバッファ容量電極を有することを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に関し、特に画素が複数の副画素に分割されている液晶表示装置に関する。

30

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置は、CRT (Cathode Ray Tube) に比べて薄くて軽量であり、低電圧で駆動でき消費電力が小さいという利点があるため、テレビ、ノート型 PC (パーソナルコンピュータ)、デスクトップ型 PC、PDA (携帯端末) および携帯電話などの電子機器に多く使用されている。特に、各画素 (サブピクセル) 毎にスイッチング素子として TFT (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ) を設けたアクティブマトリクス型液晶表示装置は、その駆動能力の高さから CRT にも匹敵する優れた表示特性を示し、デスクトップ型 PC やテレビなど従来 CRT が使用されていた分野にも広く使用されるようになった。

40

【0003】

これらの用途では、表示画面をあらゆる方向から見ることのできる高い視角特性が求められている。広視野角の得られる液晶表示装置として、MVA (Multi-domain Vertical Alignment) 方式の液晶表示装置が知られている。MVA 方式の液晶表示装置は、各画素領域内に液晶分子の配向方向が相互に異なる複数の領域 (ドメイン) を有することで高い視角特性を実現できる。

【0004】

MVA 方式のように液晶分子を基板に垂直に配向させる垂直配向型の液晶表示装置では、液晶の複屈折性を主に利用して光のスイッチングが行われる。一般に垂直配向型の液晶

50

表示装置では、表示画面の法線方向に進む光とそれより斜めの方向に進む光との間で複屈折により生じる位相差が異なるため、程度の差はあるが画面の斜め方向では全階調において階調輝度特性（特性）が設定値からずれてしまう。したがって、液晶への印加電圧に対する透過率特性（ $T-V$ 特性）は表示画面の法線方向と斜め方向とで異なるため、画面法線方向の $T-V$ 特性を最適に調整しても、斜め方向から見ると $T-V$ 特性が歪んで画面の色が白っぽく変化してしまうという現象がある。この現象は白っ茶け（*W a s h O u t*）と呼ばれている。

【0005】

白っ茶けを改善する手段として、各画素を副画素Aと副画素Bとに分割させ、副画素Aと副画素Bとでそれぞれの液晶への印加電圧を異ならせたいわゆるハーフトーン構造の液晶表示装置が提案されている。ハーフトーン構造の液晶表示装置では、画素内に異なる特性を有することで斜め方向での複屈折による位相差の正面とのズレを抑えることが可能となり、白っ茶けを抑制できる。

10

【0006】

図5はハーフトーン構造の液晶表示装置の画素構成を示している。図5に示すように、 TFT 基板は、ガラス基板10上に形成された複数のゲートバスライン12と、 SiN 膜等からなる絶縁膜を介してゲートバスライン12に交差して形成された複数のドレインバスライン14とを有している。ここで、複数のゲートバスライン12は順次走査され、図2では、 n 番目に走査される n 番目のゲートバスライン12 n と、 $(n+1)$ 番目に走査される $(n+1)$ 番目のゲートバスライン12 $(n+1)$ とを示している。

20

【0007】

ゲートバスライン12 n およびドレインバスライン14の交差位置近傍には、画素毎に形成された第1の TFT （薄膜トランジスタ）21および第2の TFT 22が互いに隣り合って配置されている。ゲートバスライン12 n の一部は第1の TFT 21および第2の TFT 22のゲート電極として機能する。ゲートバスライン12 n 上には、絶縁膜を介して第1の TFT 21の動作半導体層21 c および第2の TFT 22の動作半導体層22 c が形成されている。動作半導体層21 c 、22 c 上にはそれぞれ不図示のチャネル保護膜が形成されている。 TFT 21のチャネル保護膜上には、ドレイン電極21 a およびその下層の不図示の n 型不純物半導体層と、ソース電極21 b およびその下層の不図示の n 型不純物半導体層とが所定の間隙を介して対向して形成されている。また、 TFT 22のチャネル保護膜上には、ドレイン電極22 a およびその下層の不図示の n 型不純物半導体層と、ソース電極22 b およびその下層の不図示の n 型不純物半導体層とが所定の間隙を介して互に対向して形成されている。 TFT 21のドレイン電極21 a および TFT 22のドレイン電極22 a は、ドレインバスライン14にそれぞれ電氣的に接続されている。 TFT 21、22は並列に配置されている。 TFT 21、22上の基板全面には、 SiN 膜等の誘電体からなる不図示の保護膜が形成されている。

30

【0008】

また、ゲートバスライン12 n およびドレインバスライン14により画定された画素領域を横切って、ゲートバスライン12 n に並列して延びる蓄積容量バスライン18 n が形成されている。蓄積容量バスライン18 n 上には、絶縁膜を介して蓄積容量電極19が画素毎に形成されている。蓄積容量電極19は、接続電極25を介して TFT 21のソース電極21 b に電氣的に接続されている。絶縁膜を介して対向する蓄積容量バスライン18 n と蓄積容量電極19との間には、第1の蓄積容量が形成される。

40

【0009】

ゲートバスライン12 n およびドレインバスライン14により画定された画素領域は、副画素Aと副画素Bとに分割されている。例えば台形状の副画素Aは画素領域の中央部左寄りに配置され、副画素Bは画素領域のうち副画素Aの領域を除いた上部、下部および中央部右側端部に配置されている。画素領域内の副画素A、Bの配置は、例えば蓄積容量バスライン18 n に対しほぼ線対称になっている。副画素Aには画素電極16が形成され、副画素Bには画素電極16から電氣的に分離された画素電極17が形成されている。画素

50

電極 16、17は、共にITO等の透明導電膜により形成されている。画素電極16は、保護膜が開口されたコンタクトホール24を介して、蓄積容量電極19およびTF T 21のソース電極21bに電氣的に接続されている。画素電極17は、保護膜が開口されたコンタクトホール26を介してTF T 22のソース電極22bに電氣的に接続されている。また画素電極17は、保護膜および絶縁膜を介して蓄積容量バスライン18nに重なる領域を有している。当該領域では、保護膜および絶縁膜を介して対向する画素電極17と蓄積容量バスライン18nとの間に第2の蓄積容量が形成される。

【0010】

また、各画素領域の下方には、第3のTF T 23が配置されている。TF T 23のゲート電極は、当該画素の次段のゲートバスライン12(n+1)に電氣的に接続されている。ゲート電極上には、絶縁膜を介して動作半導体層23cが形成されている。動作半導体層23c上には、不図示のチャネル保護膜が形成されている。チャネル保護膜上には、ドレイン電極23aおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層と、ソース電極23bおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層とが所定の間隙を介して対向して形成されている。

10

【0011】

TF T 23のソース電極23bは、コンタクトホール27を介して画素電極17に電氣的に接続されている。TF T 23の近傍には、直角三角形形状のバッファ容量電極128bが配置されている。バッファ容量電極128bは、接続電極35を介してゲートバスライン12(n+1)とゲートバスライン12(n+2)との間に配置された蓄積容量バスライン18(n+1)(図5では図示せず)に電氣的に接続されている。蓄積容量バスライン18は全て同電位であるため、バッファ容量電極128bを次段の蓄積容量バスライン18(n+1)に接続しても、蓄積容量バスライン18nに接続した場合とバッファ容量電極128bの電位は変わらない。バッファ容量電極128b上には、絶縁膜を介して直角三角形形状のバッファ容量電極128aが配置されている。バッファ容量電極128aは、ドレイン電極23aに電氣的に接続されている。互いに対向して配置されたバッファ容量電極128a、128b、およびそれらの間に挟まれた絶縁膜はバッファ容量部128を構成し、バッファ容量部128にはバッファ容量が形成される。TF T 23のドレイン電極23aと蓄積容量バスライン18との間は、バッファ容量Cbを介した容量結合により間接的に接続されている。

20

30

【0012】

このように、図5に示す液晶表示装置は、画素毎に3つのTF T 21、22、23が設けられている。以下、このような液晶表示装置の構造を「3TF Tハーフトーン構造」という。

【0013】

バッファ容量電極128aが製造プロセスによりばらつくことで、各画素間でバッファ容量電極128aの面積が変動した結果、バッファ容量Cbの値が変動し、表示むらが発生するという問題がある。

【0014】

【特許文献1】特開平2-12号公報

40

【特許文献2】米国特許第4840460号明細書

【特許文献3】特許第3076938号公報

【特許文献4】特開2004-78157号公報

【特許文献5】特開2003-255303号公報

【特許文献6】特開2005-3916号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

本発明の目的は、良好な表示品質の得られる液晶表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

50

【0016】

上記目的は、基板上に互いに並列して形成された複数のゲートバスラインと、前記複数のゲートバスラインに絶縁膜を介して交差して形成された複数のドレインバスラインと、前記ゲートバスラインに並列して形成された複数の蓄積容量バスラインと、 n 番目の前記ゲートバスラインと前記ドレインバスラインの交点近傍に設置された第1及び第2の薄膜トランジスタと、前記第1の薄膜トランジスタに電氣的に接続された第1の画素電極と、前記第2の薄膜トランジスタに電氣的に接続され、前記第1の画素電極と分離された第2の画素電極と、 $(n+1)$ 番目の前記ゲートバスラインと前記ドレインバスラインの交点近傍に設置され、ソース/ドレイン電極が前記第2の画素電極に電氣的に接続された第3の薄膜トランジスタと、前記第3の薄膜トランジスタのドレイン/ソース電極に電氣的に接続された、辺の数が4以上である正多角形状の第1のバッファ容量電極と、絶縁膜を介して前記第1のバッファ容量電極に対向して配置され、前記蓄積容量バスラインに電氣的に接続された、辺の数が4以上である正多角形状の第2のバッファ容量電極とを備えたバッファ容量部とを有することを特徴とする液晶表示装置によって達成される。

10

【0017】

上記本発明の液晶表示装置において、前記辺の数が4以上である正多角形状の第1のバッファ容量電極に代えて円形状の第1のバッファ容量電極を有し、前記辺の数が4以上である正多角形状の第2のバッファ容量電極に代えて円形状の第2のバッファ容量電極を有することを特徴とする。

20

【発明の効果】

【0018】

本発明によれば、良好な表示品質の得られる液晶表示装置を実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

[第1の実施の形態]

本発明の第1の実施の形態による液晶表示装置について図1乃至図3を用いて説明する。図1は、本実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示している。図1に示すように、液晶表示装置は、TFT基板2と、対向基板4と、両基板2、4間に封止された不図示の液晶層とを有している。

30

【0020】

TFT基板2には、複数のゲートバスラインを駆動するドライバICが実装されたゲートバスライン駆動回路80と、複数のドレインバスラインを駆動するドライバICが実装されたドレインバスライン駆動回路82とが接続されている。これらの駆動回路80、82は、制御回路84から出力された所定の信号に基づいて、走査信号やデータ信号を所定のゲートバスラインあるいはドレインバスラインに出力するようになっている。TFT基板2のTFT素子形成面と反対側の面には偏光板87が配置され、対向基板4の共通電極形成面と反対側の面には、偏光板87とクロスニコルに配置された偏光板86が配置されている。偏光板87のTFT基板2と反対側の面にはバックライトユニット88が配置されている。

40

【0021】

図2は本実施の形態による液晶表示装置の1画素の構成を示している。また、図3は、この液晶表示装置の1画素の等価回路を示している。図2および図3に示すように、TFT基板2は、ガラス基板10上に形成された複数のゲートバスライン12と、SiN膜等からなる絶縁膜を介してゲートバスライン12に交差して形成された複数のドレインバスライン14とを有している。ここで、複数のゲートバスライン12は順次走査され、図2では、 n 番目に走査される n 番目のゲートバスライン12 n と、 $(n+1)$ 番目に走査される $(n+1)$ 番目のゲートバスライン12 $(n+1)$ とを示している。

【0022】

ゲートバスライン12 n およびドレインバスライン14の交差位置近傍には、画素毎に形成された第1のTFT(薄膜トランジスタ)21および第2のTFT22が互いに隣り

50

合って配置されている。ゲートバスライン12nの一部は第1のTF T 2 1および第2のTF T 2 2のゲート電極として機能する。ゲートバスライン12n上には、絶縁膜を介して第1のTF T 2 1の動作半導体層21cおよび第2のTF T 2 2の動作半導体層22cが形成されている。動作半導体層21c、22c上にはそれぞれ不図示のチャンネル保護膜が形成されている。TF T 2 1のチャンネル保護膜上には、ドレイン電極21aおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層と、ソース電極21bおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層とが所定の間隙を介して対向して形成されている。また、TF T 2 2のチャンネル保護膜上には、ドレイン電極22aおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層と、ソース電極22bおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層とが所定の間隙を介して互いに対向して形成されている。TF T 2 1のドレイン電極21aおよびTF T 2 2のドレイン電極22aは、ドレインバスライン14にそれぞれ電氣的に接続されている。TF T 2 1、22は並列に配置されている。TF T 2 1、22上の基板全面には、Si N膜等の誘電体からなる不図示の保護膜が形成されている。

10

【0023】

また、ゲートバスライン12nおよびドレインバスライン14により画定された画素領域を横切って、ゲートバスライン12nに並列して延びる蓄積容量バスライン18nが形成されている。蓄積容量バスライン18n上には、絶縁膜を介して蓄積容量電極19が画素毎に形成されている。蓄積容量電極19は、接続電極25を介してTF T 2 1のソース電極21bに電氣的に接続されている。絶縁膜を介して対向する蓄積容量バスライン18nと蓄積容量電極19との間には、第1の蓄積容量Cs1が形成される。

20

【0024】

ゲートバスライン12nおよびドレインバスライン14により画定された画素領域は、副画素Aと副画素Bとに分割されている。例えば台形状の副画素Aは画素領域の中央部左寄りに配置され、副画素Bは画素領域のうち副画素Aの領域を除いた上部、下部および中央部右側端部に配置されている。画素領域内の副画素A、Bの配置は、例えば蓄積容量バスライン18nに対しほぼ線対称になっている。副画素Aには第1の画素電極16が形成され、副画素Bには画素電極16から電氣的に分離された第2の画素電極17が形成されている。画素電極16、17は、共にITO等の透明導電膜により形成されている。画素電極16は、保護膜が開口されたコンタクトホール24を介して、蓄積容量電極19およびTF T 2 1のソース電極21bに電氣的に接続されている。画素電極17は、保護膜が開口されたコンタクトホール26を介してTF T 2 2のソース電極22bに電氣的に接続されている。また画素電極17は、保護膜および絶縁膜を介して蓄積容量バスライン18nに重なる領域を有している。当該領域では、保護膜および絶縁膜を介して対向する画素電極17と蓄積容量バスライン18nとの間に第2の蓄積容量Cs2が形成される。

30

【0025】

また、各画素領域の下方には、第3のTF T 2 3が配置されている。TF T 2 3のゲート電極は、当該画素の次段のゲートバスライン12(n+1)に電氣的に接続されている。ゲート電極上には、絶縁膜を介して動作半導体層23cが形成されている。動作半導体層23c上には、不図示のチャンネル保護膜が形成されている。チャンネル保護膜上には、ドレイン電極23aおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層と、ソース電極23bおよびその下層の不図示のn型不純物半導体層とが所定の間隙を介して対向して形成されている。

40

【0026】

TF T 2 3のソース電極23bは、コンタクトホール27を介して画素電極17に電氣的に接続されている。TF T 2 3の近傍には、バッファ容量電極28bが配置されている。バッファ容量電極28bは、接続電極35を介してゲートバスライン12(n+1)とゲートバスライン12(n+2)との間に配置された蓄積容量バスライン18(n+1)(図2では図示せず)に電氣的に接続されている。蓄積容量バスライン18は全て同電位であるため、バッファ容量電極28bを次段の蓄積容量バスライン18(n+1)に接続しても、蓄積容量バスライン18nに接続した場合とバッファ容量電極28bの電位は変

50

わらない。バッファ容量電極 28 b 上には、絶縁膜を介してバッファ容量電極 28 a が配置されている。バッファ容量電極 28 a は、ドレイン電極 23 a に電氣的に接続されている。互いに対向して配置されたバッファ容量電極 28 a、28 b、およびそれらの間に挟まれた絶縁膜はバッファ容量部 28 を構成し、バッファ容量部 28 にはバッファ容量 C b が形成される。T F T 23 のドレイン電極 23 a と蓄積容量バスライン 18 との間は、バッファ容量 C b を介した容量結合により間接的に接続されている。

【0027】

対向基板 4 は、ガラス基板上に形成された C F 樹脂層と、C F 樹脂層上に形成され、蓄積容量バスライン 18 と同電位に維持される共通電極 41 とを有している。T F T 基板 2 と対向基板 4 との間には、例えば負の誘電率異方性を有する液晶が封止されて液晶層が形成されている。副画素 A の画素電極 16、共通電極 41、およびそれらの間に挟まれた液晶層 1 により液晶容量 C l c 1 が形成され、副画素 B の画素電極 17、共通電極 41、およびそれらの間に挟まれた液晶層により液晶容量 C l c 2 が形成される。T F T 基板 2 の液晶層との界面には配向膜（垂直配向膜）が形成され、対向基板 4 の液晶層 6 との界面には配向膜（垂直配向膜）が形成されている。これにより、液晶層の液晶分子は、電圧無印加時に基板面にほぼ垂直に配向する。

10

【0028】

3 T F T ハーフトーン構造の液晶表示装置では、ゲートバスライン 12 n が選択状態になって T F T 21、22 がオン状態になると、副画素 A、B の各液晶容量 C l c 1、C l c 2 に一旦同じ電圧が印加される。その後、次段のゲートバスライン 12 (n + 1) が選択状態になって第 3 の T F T 23 がオン状態になると、副画素 B の液晶容量 C l c 2 に蓄えられた電荷がバッファ容量 C b に移動することにより副画素 B の液晶容量 C l c 2 の電圧が低下し、副画素 A の液晶容量 C l c 1 の電圧と副画素 B の液晶容量 C l c 2 の電圧とに差が生じる。

20

【0029】

このように、液晶層に印加される電圧が互いに異なる副画素 A、B が 1 画素内に存在すると、液晶層への印加電圧に対する透過率特性（T - V 特性）の歪みが副画素 A、B で分散される。このため、白っ茶け（斜め方向から見たときに画像の色が白っぽくなる現象）を抑制でき、視角特性が改善される。

【0030】

また、3 T F T ハーフトーン構造の液晶表示装置では、副画素 B の画素電極 17 が T F T 22 を介してドレインバスライン 14 に接続されている。T F T 22 の動作半導体層 22 c の電気抵抗は、オフ状態であっても絶縁膜や保護膜等の電気抵抗よりも極めて低い。このため、画素電極 17 に蓄えられた電荷は容易に放電されるようになっている。したがって本実施の形態によれば、広視野角の得られるハーフトーン法を用いているのにもかかわらず、濃い焼付きが生じることがない。

30

【0031】

本実施の形態によれば、バッファ容量電極 28 a の形状が正方形なので、図 5 に示す従来の直角三角形のバッファ容量電極 128 a と比較して、製造プロセスによるばらつきの影響を受けにくくなるため、表示むらのない良好な表示品質が得られる。

40

【0032】

【表 1】

バッファ容量電極の形状	正方形		直角三角形	
	1 μm 細り	1 μm 太り	1 μm 細り	1 μm 太り
設計値S [μm^2]	100.00	100.00	100.00	100.00
出来あがり面積 [μm^2]	64.00	144.00	62.05	146.89
差分 [μm^2]	-36.00	44.00	-37.95	46.89
変化量 [%]	-36.00	44.00	-37.95	46.89

10

【0033】

表 1 は、バッファ容量電極の面積が設計値 S からずれた場合の正方形と直角三角形とのバッファ容量電極の面積の差を示している。バッファ容量電極の面積の設計値 S が $100 \mu\text{m}^2$ であり、製造プロセスでオーバーエッチングにより、パターンが $1 \mu\text{m}$ 細ると仮定した場合の出来あがり面積は、表 1 に示すとおり正方形のバッファ容量電極 28a で

$$\text{出来上がり面積} [\mu\text{m}^2] = (10 - 2) [\mu\text{m}] \times (10 - 2) [\mu\text{m}] = 64 \mu\text{m}^2$$

直角三角形のバッファ容量電極 128a で約 $62.05 \mu\text{m}^2$ となり、正方形のバッファ容量電極 28aの方が設計値に対して約 1.95% 有利となる。

20

【0034】

逆に、パターンが $1 \mu\text{m}$ 太ると出来あがり面積は、正方形のバッファ容量電極 28a で

$$\text{出来上がり面積} [\mu\text{m}^2] = (10 + 2) [\mu\text{m}] \times (10 + 2) [\mu\text{m}] = 144 \mu\text{m}^2$$

直角三角形のバッファ容量電極 128a で約 $146.89 \mu\text{m}^2$ となり、正方形のバッファ容量電極 28aの方が設計値に対して約 2.89% 有利となる。

30

【0035】

以上の結果から、正方形のバッファ容量電極 28a を用いた 3TFT ハーフトーン構造の液晶表示装置において、図 5 に示す従来の直角三角形のバッファ容量電極 128a を用いた場合と比較して、製造プロセスによるバッファ容量電極の面積変動を少なくし、各画素間でのバッファ容量 Cb の変動による表示むらを軽減できることが分かる。

【0036】

[第 2 の実施の形態]

本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置について図 4 を用いて説明する。図 4 は、本実施の形態による液晶表示装置の 1 画素の構成を示している。なお本実施の形態による液晶表示装置等の説明において、第 1 の実施の形態と同一の機能、作用を奏する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

40

【0037】

本実施の形態による液晶表示装置では、第 1 の実施の形態の正方形のバッファ容量電極 28a に代えて円形状のバッファ容量電極 38a が配置され、正方形のバッファ容量電極 28b に代えて円形状のバッファ容量電極 38b が配置されている。

【0038】

バッファ容量電極 38b は、接続電極 35 を介してゲートバスライン 12 (n+1) とゲートバスライン 12 (n+2) との間に配置された蓄積容量バスライン 18 (n+1) (図 4 では図示せず) に電氣的に接続されている。バッファ容量電極 38a は、ドレイン電極 23a に電氣的に接続されている。互いに対向して配置されたバッファ容量電極 38a、38b、およびそれらの間に挟まれた絶縁膜はバッファ容量部 38 を構成し、バッフ

50

ァ容量部 38 にはバッファ容量 C b が形成される。T F T 23 のドレイン電極 23 a と蓄積容量バスライン 18 との間は、バッファ容量 C b を介した容量結合により間接的に接続されている。

【0039】

本実施の形態によれば、バッファ容量電極 38 a の形状が円形なので、図 5 に示す従来の直角三角形形状のバッファ容量電極 128 a と比較して、製造プロセスによるばらつきの影響を受けにくくなるため、表示むらのない良好な表示品質が得られる。

【0040】

【表 2】

10

バッファ容量電極の形状	円形		正方形		直角三角形	
	1 μ m細り	1 μ m太り	1 μ m細り	1 μ m太り	1 μ m細り	1 μ m太り
設計値 S [μ m ²]	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
出来あがり面積 [μ m ²]	67.60	138.44	64.00	144.00	62.05	146.89
差分 [μ m ²]	-32.40	38.44	-36.00	44.00	-37.95	46.89
変化量 [%]	-32.40	38.44	-36.00	44.00	-37.95	46.89

20

【0041】

表 2 は、バッファ容量電極の形状が円形、正方形および直角三角形の場合のバッファ容量電極の面積の差を示している。表 2 に示すとおり、バッファ容量電極の面積の設計値 S が 100 μ m² であり、製造プロセスによりオーバーエッチングにより、パターンが 1 μ m 細ると仮定した場合の出来あがり面積は、円形状のバッファ容量電極 38 a で約 67.6 μ m²、直角三角形形状のバッファ容量電極 128 a で約 62.05 μ m² となり、円形の方が設計値に対して約 5.55% 有利となる。

30

【0042】

逆に、パターンが 1 μ m 太ると出来あがり面積は、円形状のバッファ容量電極 38 a で約 138.44 μ m²、直角三角形形状のバッファ容量電極 128 a で約 146.89 μ m² となり、円形状のバッファ容量電極 38 a の方が設計値に対して約 8.45% 有利となる。

【0043】

以上の結果から、バッファ容量電極 38 a の形状を円形とすることで、図 5 に示す従来の直角三角形のバッファ容量電極 128 a と比較して、製造プロセスによるバッファ容量電極 38 a の面積変動を少なくし、各画素間でのバッファ容量 C b の変動による表示むらを軽減できることが分かる。

40

【0044】

以上説明したように、本発明によれば、3 T F T ハーフトーン構造の液晶表示装置において、表示むらの原因となるバッファ容量 C b の変動を抑止できる。これにより、焼付きが生じ難く、表示むらのない表示特性を安定して得られる広視野角の液晶表示装置を実現できる。なお、本実施の形態では基本的に M V A 方式等の V A モードの液晶表示装置への適用を念頭に置いた画素構成となっているが、原理や効果は V A モードに限定されるものではなく、T N、I P S、O C B 等のあらゆる液晶モードの液晶表示装置に適用可能である。

【0045】

本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。

50

例えば、上記実施の形態では正方形のバッファ容量電極 28 a、28 b を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、辺の数が 5 以上の正多角形状のバッファ容量電極にも適用できる。

【0046】

また上記実施の形態ではバッファ容量電極 28 b が接続電極 35 を介してゲートバスライン 12 (n+1) とゲートバスライン 12 (n+2) との間に配置された蓄積容量バスライン 18 (n+1) に電氣的に接続されている液晶表示装置を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、バッファ容量電極 28 b がゲートバスライン 12 n とゲートバスライン 12 (n+1) との間に配置された蓄積容量バスライン 18 n に電氣的に接続されている液晶表示装置にも適用できる。

10

【0047】

また上記実施の形態では透過型の液晶表示装置を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、反射型や半透過型等の他の液晶表示装置にも適用できる。

【0048】

また上記実施の形態では、対向基板 4 上に CF 樹脂層が形成された液晶表示装置を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、TF T 基板 2 上に CF 樹脂層が形成された、いわゆる CF-on-TF T 構造の液晶表示装置にも適用できる。

【図面の簡単な説明】

【0049】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。

20

【図 2】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の 1 画素の構成を示す図である。

【図 3】本発明の第 1 の実施の形態による液晶表示装置の 1 画素の等価回路を示す図である。

【図 4】本発明の第 2 の実施の形態による液晶表示装置の 1 画素の構成を示す図である。

【図 5】従来の液晶表示装置の 1 画素の構成を示す図である。

【符号の説明】

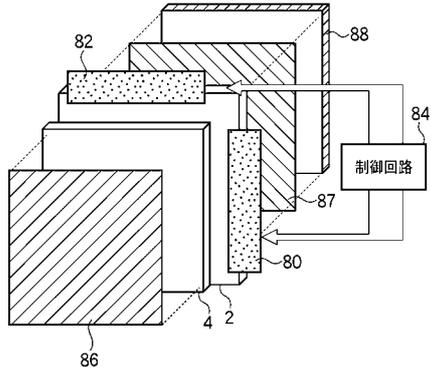
【0050】

- 2 TF T 基板
- 4 対向基板
- 10 ガラス基板
- 12 ゲートバスライン
- 14 ドレインバスライン
- 16、17 画素電極
- 18 蓄積容量バスライン
- 19 蓄積容量電極
- 21、22、23 TF T
- 21 a、22 a、23 a ドレイン電極
- 21 b、22 b、23 b ソース電極
- 21 c、22 c、23 c 動作半導体層
- 24、26、27 コンタクトホール
- 28、38 バッファ容量部
- 28 a、28 b、38 a、38 b バッファ容量電極
- 35 接続電極
- 41 共通電極
- 80 ゲートバスライン駆動回路
- 82 ドレインバスライン駆動回路
- 84 制御回路
- 86、87 偏光板
- 88 バックライトユニット

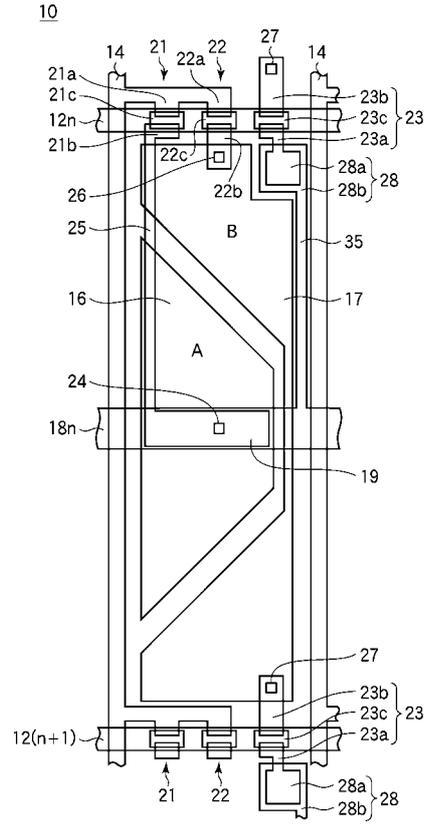
30

40

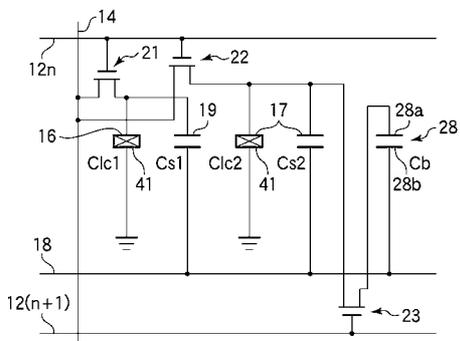
【 図 1 】



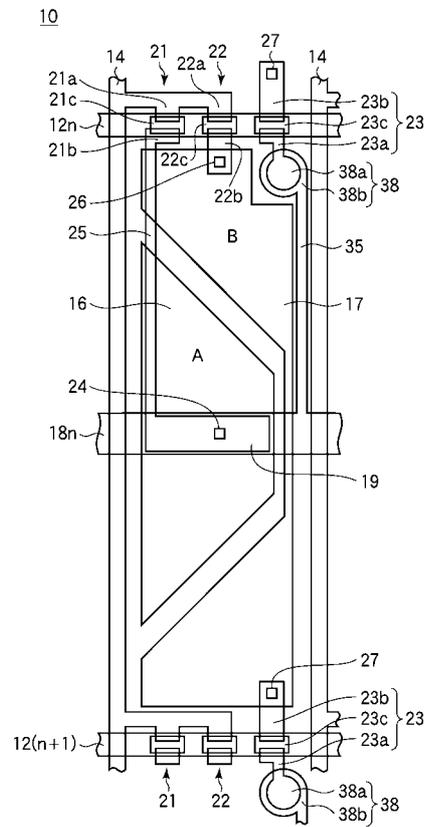
【 図 2 】



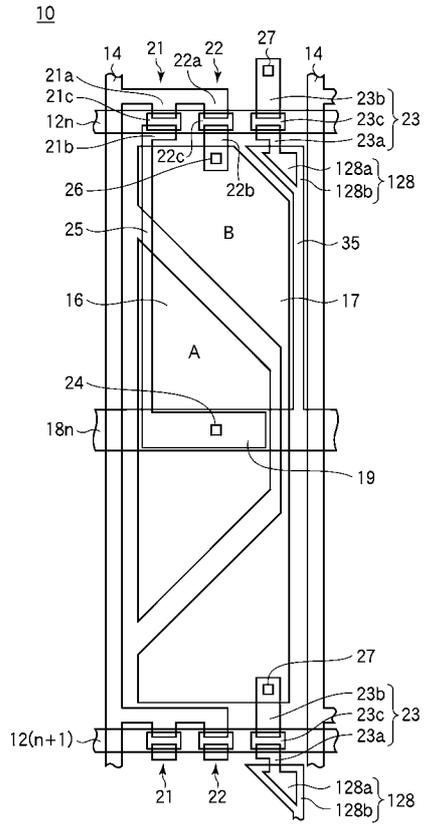
【 図 3 】



【 図 4 】



【 図 5 】



专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP2006330634A	公开(公告)日	2006-12-07
申请号	JP2005158069	申请日	2005-05-30
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	木原正博 田口善久		
发明人	木原 正博 田口 善久		
IPC分类号	G02F1/1368		
CPC分类号	G02F1/13624 G02F1/134309 G02F1/136213 G02F1/1393 G02F2001/134345		
FI分类号	G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H092/GA11 2H092/JA24 2H092/JA37 2H092/JA41 2H092/JA46 2H092/JB22 2H092/JB31 2H092/NA01 2H092/PA01 2H092/PA02 2H092/PA06 2H092/PA08 2H092/PA11 2H092/PA13 2H092/JB42 2H192/AA24 2H192/BC24 2H192/BC26 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB12 2H192/CC04 2H192/DA12 2H192/DA15 2H192/DA43 2H192/DA52 2H192/EA43 2H192/JA13		
代理人(译)	盛冈正树		
其他公开文献	JP4731206B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够获得良好显示特性的液晶显示装置。 解决方案：第一和第二TFT 21,22设置在第n栅极总线12n和漏极总线14的交叉点附近，第一像素电极16电连接到TFT 21，第二像素电极17，其电连接到TFT 22并与第一像素电极16分离，第三TFT 23，其源电极电连接到第二像素电极17，以及第三像素电极17第一缓冲电容器电极28a，具有方形形状并且电连接到TFT 23的TFT 23的漏电极23a和存储电容器总线18并且，第二缓冲电容器电极28b具有方形形状并且电连接到第二缓冲电容器电极28b。 .The

